

# Аномалии концентрационного тушения люминесценции активированных нанокристаллов $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$

**Н. В. Знаменский, А. Ю. Шашков, Ю. В. Орлов, Т. Г. Юкина, Ю. В. Малюкин<sup>+</sup>, П. Н. Жмурин<sup>+</sup>, Ю. Н. Велихов<sup>+</sup>, И. И. Ганина<sup>+</sup>**

*Российский научный центр “Курчатовский институт”<sup>1)</sup>, 123182 Москва, Россия*

*+Институт сцинтилляционных материалов, НТК “Институт монокристаллов” НАН Украины, 61001 Харьков, Украина*

Поступила в редакцию 27 июня 2006 г.

В нанокристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  наблюдалась упорядоченная фаза на кривых затухания  $^1D_2$ -люминесценции ионов  $\text{Pr}^{3+}$  при их аномально низкой концентрации (0.5 ат.%). Эффект обусловлен преимущественным скоплением ионов активатора вблизи поверхности нанокристалла, обеспечивающим релаксацию упругих напряжений, возникающих в результате несовпадения ионных радиусов  $\text{Pr}^{3+}$  и  $\text{Y}^{3+}$ . Концентрационное тушение  $\text{Pr}^{3+}$ -люминесценции обусловлено кооперативной кросс-релаксацией.

PACS: 78.67.-n, 78.67.Bf

Активированные нанокристаллы являются объектами интенсивных исследований, которые проводятся в двух главных направлениях: изучение фундаментальных закономерностей проявления размерного эффекта в таких системах [1–7] и создание контролируемых технологий получения нанокристаллов с заданными свойствами [7–11]. Активированные нанокристаллы обладают неограниченной фотостойкостью, что делает их чрезвычайно перспективными для применения в качестве люминесцентных меток в биологии и медицине [12, 13].

Ясно, что сильно локализованные электронные состояния примесного иона не чувствительны к изменению размера кристалла, вплоть до нанометров. Однако, его люминесцентная динамика, межионные взаимодействия и фонон-зависимые релаксационные процессы могут существенно модифицироваться в результате размерного квантования колебательного спектра нанокристалла [1–3, 5–7]. В силу пространственного ограничения миграции электронных возбуждений, для нанокристаллов  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Eu}^{3+}$  обнаружен значительно более высокий порог концентрационного тушения  $\text{Eu}^{3+}$ -люминесценции [14]. В объемных кристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$ , при отсутствии миграции энергии электронного возбуждения, установлено два механизма тушения  $^1D_2$ -люминесценции примесных ионов [15]. Температурно-зависимый  $^1D_2 \rightarrow ^1D_2$  перенос энергии между неэквивалентными оптическими центрами и кооперативная кросс-релаксация [15].

В настоящей статье представлены результаты исследования концентрационного тушения  $^1D_2$ -люминесценции примесных ионов в нанокристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$ . В противоположность выводам [14], в нанокристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  наблюдается более сильное концентрационное тушение по сравнению с объемными кристаллами. При достаточно низкой концентрации примесных ионов (0.5 ат.%), кривые затухания  $^1D_2$ -люминесценции ионов  $\text{Pr}^{3+}$  демонстрируют упорядоченную фазу с линейной временной зависимостью и неупорядоченную фазу с временной зависимостью  $t^{0.41}$ . В кристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  с концентрацией примесных ионов вплоть до 1.8 ат.% упорядоченная фаза не наблюдалась. Определенные из эксперимента на упорядоченной и неупорядоченной фазах затухания  $^1D_2$ -люминесценции микропараметры скорости переноса указывают на разные механизмы тушения в ближнем и дальнем окружении примесных ионов  $\text{Pr}^{3+}$ .

Нанокристаллы  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  с различным содержанием примесных ионов от 0.01 ат.% до 10 ат.% были получены золь-гель-методом. Высокотемпературный отжиг проводился в воздушной среде в течение 5 ч при температуре 1100 °С. Средний размер нанокристаллов контролировался рентгенографически и составлял порядка 20 нм. Для исследования люминесценции нанокристаллов полученный порошок диспергировался в воде и в виде капли помещался на предметное стекло. Образец был готов к исследованию после испарения воды. Конфокальная схема возбуждения и регистрации люминесценции через объектив микроскопа позволяла работать с отдельной светящейся частицей при изменении температуры от азот-

<sup>1)</sup>e-mail zarja@issph.kiae.ru

ной до комнатной. Спектры люминесценции записывались на решеточном монохроматоре, а кривые затухания  $\text{Pr}^{3+}$ -люминесценции регистрировались методом время-коррелированного счета одиночных фотонов.

Исследование спектров возбуждения люминесценции в области  $^3H_4 \rightarrow ^1D_2$  поглощения ионов  $\text{Pr}^{3+}$  показало, что аналогично объемным кристаллам, нанокристаллы  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  имеют два типа оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$ , которые возникают в результате замещения двух неэквивалентных катионных узлов решетки  $\text{Y}_2\text{SiO}_5$  ионами  $\text{Pr}^{3+}$ . Параметры расщепления термов  $^1D_2$  и  $^3H_4$  оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  обоих типов в нанокристаллах сохранялись (рис.1). Люминесценция нанокристаллов

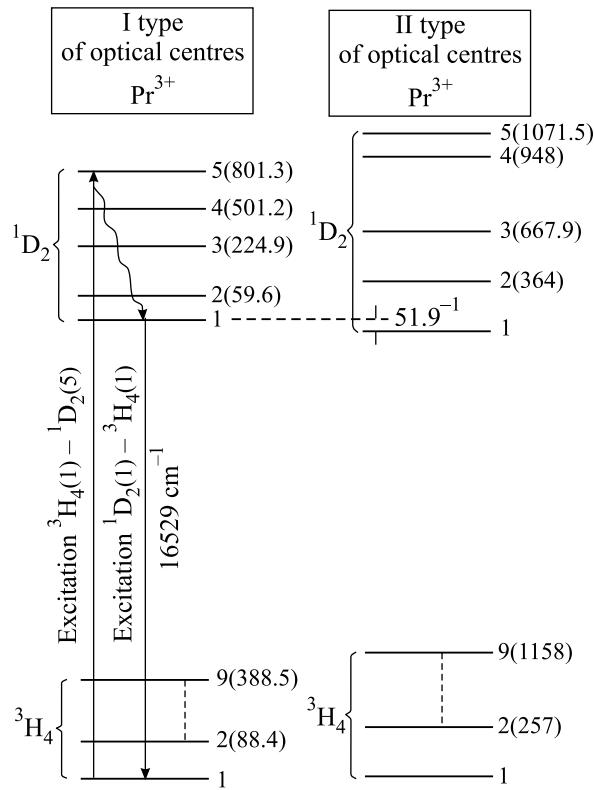


Рис.1. Упрощенная схема структуры электронных термов неэквивалентных оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  в нанокристалле  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$ . Цифрами указаны штарковские компоненты, а в скобках даны их относительные энергии. Термы  $^1G_4$ ,  $^3F_4$ ,  $^3F_3$ ,  $^3F_2$ ,  $^3H_6$  и  $^3H_5$ , которые располагаются между термом основного состояния  $^3H_4$  и термом  $^1D_2$  не показаны. Энергетический масштаб на схеме не соблюден

$\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  возбуждалась перестраиваемым по частоте лазерным излучением, резонансным оптическому переходу  $^3H_4(1) \rightarrow ^1D_2(5)$  между нижней штарковской компонентой терма  $^3H_4$  и верхней штар-

ковской компонентой терма  $^1D_2$  оптических центров первого типа (рис.1). Во всем диапазоне изменения концентраций мы наблюдали типичный спектр  $^1D_2$ -люминесценции оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа и не наблюдали спектра  $^1D_2$ -люминесценции оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  второго типа. Как и в кристаллах [15],  $^1D_2 \rightarrow ^1D_2$  перенос энергии электронного возбуждения в этом случае отсутствовал. Кривые затухания люминесценции исследовались на резонансном  $^1D_2(1) \rightarrow ^3H_4(1)$  переходе оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа (рис.1).

В образцах с низким уровнем концентрации ионов  $\text{Pr}^{3+}$  (0.01 ат.-%–0.1 ат.%) закон затухания люминесценции оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа носил экспоненциальный характер с постоянной затухания  $\tau_0 \sim 110$  мкс, которая была отождествлена с радиационным временем жизни. С повышением концентрации примесных ионов временная зависимость затухания  $^1D_2$ -люминесценции оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа приобретала неэкспоненциальный характер. Это обусловлено тушением люминесценции в результате кросс-релаксации энергии электронного возбуждения  $^1D_2$ -терма оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа. Согласно данным [16, 17], кросс-релаксация может быть реализована по схеме:  $^1D_2 \rightarrow ^1G_4$  (возбужденный ион) и  $^3H_4 \rightarrow ^3F_4$  (невозбужденный ион). Для нанокристаллов  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$ , обладающих двумя неэквивалентными оптическими центрами  $\text{Pr}^{3+}$  с близкой структурой электронных термов, кросс-релаксация может протекать с участием оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  обоих типов. Мы не обнаружили температурной зависимости кривых затухания  $^1D_2$ -люминесценции во всех исследуемых образцах в интервале 80–300 К. А это означает, что миграция энергии в примесной подсистеме нанокристалла отсутствует и мы имеем дело с одношаговым актом переноса в системе донор-акцептор.

С целью интерпретации кривых затухания  $^1D_2$ -люминесценции были построены так называемые, функции тушения  $P(t) = \ln(I(t)/I_0) + t/\tau_0$ , которые представлены на (рис.2а). В общем случае для временной зависимости  $P(t)$  можно выделить два характерных интервала [7, 8]. Начальный, так называемая упорядоченная фаза, где  $P(t) \sim t$ , и неупорядоченная фаза с  $P(t) \sim t^{0.5}$  [19]. Для определения показателя степени временного спада экспериментальных кривых  $P(t)$  (рис.2а) были построены зависимости  $\ln(-\ln P(t))$  от  $\ln(t)$  (рис.2б). Из рис.2б следует, что на экспериментальных кривых  $P(t)$  для нанокристаллов  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  с 1 ат.%, 2 ат.% и 4 ат.% примесных ионов можно четко выде-

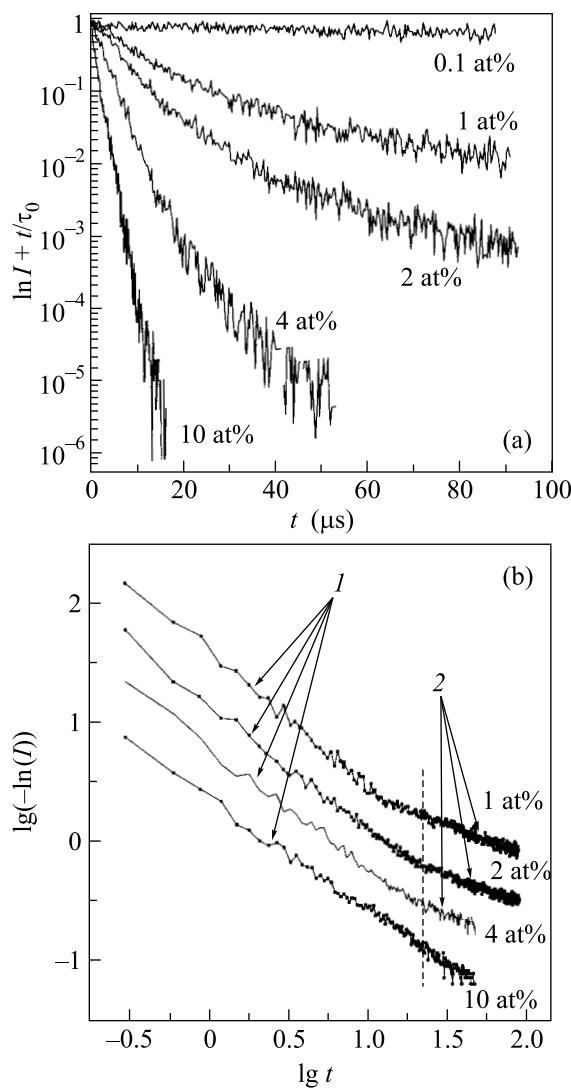


Рис.2. (а) Функции тушения люминесценции на переходе  ${}^1D_2(1) \rightarrow {}^3H_4(1)$  оптических центров первого типа в нанокристаллах с разной концентрацией примесных ионов; (б) те же функции тушения, перестроенные в соответствующей системе координат (1 – упорядоченная фаза, 2 – неупорядоченная фаза)

лиль два временных участка с линейной и близкой к корневой временной зависимостью. Изменение характера временной зависимости наступает при  $t^* \sim 15$  мкс. Упорядоченная фаза концентрационного тушения в нанокристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  проявляется уже при 0.5 ат.% ионов  $\text{Pr}^{3+}$ , а для концентрации выше, чем 6 ат.%, наблюдается только упорядоченная фаза (рис.2б). Следует отметить, что для объемных кристаллов  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$ , вплоть до концентрации 1.8 ат.% ионов  $\text{Pr}^{3+}$ , упорядоченная фаза не наблюдалась [6].

Из анализа кривых  $P(t)$  (рис.2а) следует, что для концентраций 1 ат.%, 2 ат.% и 4 ат.% на упорядоченной фазе тушится 66%, 83% и практически 100% возбужденных оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа. Но в то же время хорошо известно, что упорядоченная фаза возникает, когда эффект статистического усреднения исчезает в результате образования пар “донор-акцептор”, разделенных минимальным расстоянием, которое допускается данным типом кристаллической решетки [18, 19]. Если при кросс-релаксации энергии электронного возбуждения задействованы два иона  $\text{Pr}^{3+}$ , то из эксперимента следует, что при 1 ат.% примесных ионов в нанокристалле 66% оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа имеет невозбужденный ион  $\text{Pr}^{3+}$  на ближайшем расстоянии. При условии случайного распределения примесных ионов по катионным узлам концентрация 1 ат.% слишком мала, чтобы обеспечить возникновение упорядоченной фазы.

Действительно, из структуры решетки  $\text{Y}_2\text{SiO}_5$  следует, что катионный узел  $\text{Y}_1$  имеет два и пять однотипных катионных узлов, удаленных на 3.47, 3.61 Å и соответственно 5.46, 5.46, 5.48, 5.48, 5.99 Å. Кроме того, вокруг катионного узла  $\text{Y}_1$  располагается девять неэквивалентных катионных узлов  $\text{Y}_2$  на расстояниях 3.4, 3.52, 3.73, 4.15, 4.68, 4.93, 5.17, 5.71, 5.8 Å. Следовательно, на ближайшем расстоянии от оптического центра  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа может разместиться два иона того же типа и три иона в неэквивалентных катионных узлах. Если воспользоваться формулой повторных испытаний [19], то при общей концентрации примесных ионов 1 ат.% доля оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа, имеющих эквивалентного соседа в ближайшем узле, составит  $\sim 1.4\%$ . В случае неэквивалентного соседа эта доля еще меньше, так как ионы распределяются по неэквивалентным катионным узлам в пропорции 5:1 [15, 16]. Доля примесных ионов, имеющих соседа в ближайшем окружении, для нанокристаллов может возрасти из-за особенностей заселения доступных позиций вблизи поверхности [20]. Воспользовавшись выкладками работы [20], мы установили, что для нанокристаллов со средним размером 20 нм число примесных ионов, имеющих соседа, увеличится на 12%. Представленные оценки показывают, что процент оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$  первого типа, имеющих ближайшего соседа, явно не соответствует найденному из эксперимента. Возникновение упорядоченной фазы на кривых затухания  ${}^1D_2$ -люминесценции (рис.2), при относительно малой концентрации примесных ионов, позволяет сделать предположение о преимущественном скоплении ионов  $\text{Pr}^{3+}$  на периферии нанокристалла.

талла. Тогда вероятность образования соседей у примесного иона значительно возрастает. Дополнительные напряжения, которые возникают в кристаллической решетке из-за того, что ион  $\text{Pr}^{3+}$  имеет больший ионный радиус по сравнению с ионом  $\text{Y}^{3+}$ , могут быть причиной, способствующей скоплению примесных ионов на периферии нанокристалла. Подобное неравномерное распределение примесных ионов In в тонких пленках и нанокристаллах  $\text{As}_{1-x}\text{In}_x\text{Ga}$  было установлено прямыми методами [21, 22].

Проведенные вычисления микропараметра скорости переноса  $C_{DA}$  из упорядоченной ( $\sim 3 \cdot 10^{-39} \text{ см}^6 \cdot \text{с}^{-1}$ ) и неупорядоченной ( $\sim 2.6 \cdot 10^{-38} \text{ см}^6 \cdot \text{с}^{-1}$ ) фаз функции тушения (рис.2а) разнятся почти на порядок. Указанные различия в значениях  $C_{DA}$  позволяют говорить о том, что механизм тушения ионов в ближнем и дальнем окружении носит различный характер. Кроме того, при анализе неупорядоченной фазы затухания  ${}^1D_2$ -люминесценции в интервале 15–90 мкс нам не удалось достичь хорошей аппроксимации экспериментальных кривых ни при диполь-дипольном (временная зависимость  $t^{0.5}$ ) ни при диполь-квадрупольном (временная зависимость  $t^{0.375}$ ) взаимодействии примесных ионов. Перестроенные в координатах  $\{P(t), t^{0.5}\}$  экспериментальные точки значительно отклонялись от прямой (рис.3а). Для диполь-квадрупольного взаимодействия между примесными ионами аппроксимация экспериментальных точек прямой линией в координатах  $\{P(t), t^{0.375}\}$  выглядела более предпочтительно (рис.3а). Однако, как и в случае кристаллов [15], наилучшая аппроксимация была достигнута при временной зависимости  $t^{0.41}$  (рис.3). Временная зависимость  $t^{0.41}$  появляется при диполь-дипольном механизме кооперативной кросс-релаксации [23]. В этом случае два невозбужденных иона  $\text{Pr}^{3+}$  выступают в качестве кооперативного акцептора [23]. Однако из наклона экспериментальных кривых для разных концентраций, построенных в координатах  $\{P(t), t^{0.41}\}$ , не следовала четкая квадратичная концентрационная зависимость константы переноса. Эта зависимость слабо отличалась от линейной. Видимо, это связано с тем, что в качестве кооперативного акцептора выступает пара неэквивалентных оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$ . Из общих соображений следует, что константа переноса на кооперативный акцептор должна быть пропорциональна произведению их концентраций  $W_{DA}^{\text{coop}} \sim c_1 \cdot c_2$ . А как было показано в [16], при увеличении концентрации примесные ионы  $\text{Pr}^{3+}$  неравномерно распределяются между неэквивалентными катионными узлами

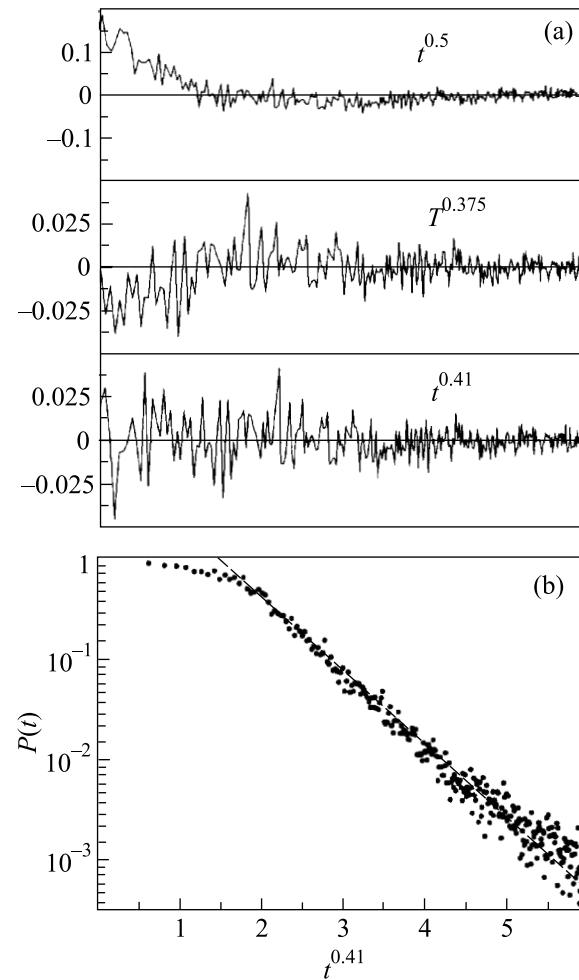


Рис.3. (а) Отклонение экспериментальных точек  $P(t)$  от прямых линий в координатах  $\{P(t), t^{0.5}\}$ ,  $\{P(t), t^{0.375}\}$  и  $\{P(t), t^{0.41}\}$  (концентрация 1 ат.-%); (б) аппроксимация прямой линией функции тушения  $P(t)$  для концентрации 1 ат.-% в координатах  $\{P(t), t^{0.41}\}$

криスタлла  $\text{Y}_2\text{SiO}_5$ . Преимущественно ионы  $\text{Pr}^{3+}$  расходуются на образование оптических центров первого типа. Следовательно,  $c_2$  растет не пропорционально изменению общей концентрации. Следовательно, квадратичная зависимость  $W_{DA}^{\text{coop}}$  от концентрации может отсутствовать.

Таким образом, в результате неравномерного распределения примесных ионов в объеме нанокристалла  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  уже при уровне концентрации 0.5 ат.-% наблюдается упорядоченная фаза на кривых затухания  ${}^1D_2$ -люминесценции, что в объемных кристаллах  $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Pr}^{3+}$  не наблюдалось при концентрациях 1.8 ат.-%. Микропараметры переноса, определенные по упорядоченной и неупорядоченной фазам развития тушения, показали их отличие прак-

тически на порядок, что возможно только в случае изменения характера взаимодействия между примесными ионами в ближнем и дальнем окружении. Наилучшая аппроксимация экспериментальных кривых на неупорядоченной фазе затухания была достигнута временной зависимостью  $t^{0.41}$ , указывающей на кооперативную кросс-релаксацию энергии электронного возбуждения примесных ионов  $\text{Pr}^{3+}$ . Сложная структура кооперативного акцептора, который состоит из неэквивалентных оптических центров  $\text{Pr}^{3+}$ , и особенности распределения примесных ионов по неэквивалентным катионным узлам являются причиной неквадратичной зависимости константы переноса на кооперативный акцептор.

1. X. Wang, S. H. Huang, R. Reeves et al., *J. Lumin.* **94-95**, 229 (2001).
2. R. S. Meltzer, W. M. Yen, H. Zheng et al., *Phys. Rev. B* **66**, 224 (2002).
3. G. K. Liu, H. Z. Zhuang, and X. Y. Chen, *Nano Letters* **2**, 535 (2002).
4. A. P. Bartko, L. A. Peyser, R. M. Dickson et al., *Chem. Phys. Lett.* **358**, 459 (2002).
5. D. T. Simon and M. R. Geller, *Phys. Rev. B* **64**, 115412 (2001).
6. Yu. V. Malyukin, A. A. Masalov, and P. N. Zhmurin, *Phys. Lett. A* **316**, 147 (2003).
7. Yu. V. Malyukin, A. A. Masalov, and P. N. Zhmurin, *Optics Commun.* **239**, 409 (2004).
8. G. Wakefield, H. A. Keron, P. J. Dobson, and J. L. Hutchison, *J. Phys. and Chemistry of Solids* **60**, 503 (1999).
9. P. Hoyer, R. Eichberger, and H. Weller, *Ber. Bunsenges Phys. Chem.* **97**, 631 (1993).
10. R. N. Bhargawa, D. Gallager, and X. Hong, *Phys. Rev. Lett.* **72**, 416 (1994).
11. M. A. Hines and P. Guyot-Sionnest, *J. Phys. Chem.* **100**, 468 (1996).
12. W. C. W. Chan and S. Nie, *Science* **281**, 2016 (1998).
13. H. Harma, T. Soukka, and T. Lovgren, *Clinical Chemistry* **47:6**, 561 (2001).
14. W. Zhang, P. Xie, C. Duan et al., *Chem. Phys. Lett.* **292**, 133 (1998).
15. Yu. V. Malyukin, A. A. Masalov, P. N. Zhmurin et al., *Phys. Stat. Sol. (b)* **240**, 655 (2003).
16. Ю. В. Малюкин, Р. С. Борисов, П. Н. Жмурин и др., *ФНТ* **27**, 780 (2001).
17. H. Chen, R. Lian, M. Yin et al., *J. Phys.: Condens. Matter* **13**, 1151 (2001).
18. С. И. Голубов, Ю. В. Конобеев, *ФТТ* **13**, 3185 (1973).
19. Ю. К. Воронько, Т. Г. Мамедов, В. В. Осико и др., *ЖЭТФ* **71**, 478 (1973).
20. J. F. Suyver, R. Meester, J. J. Kelly, and A. Meijerink, *Phys. Rev. B* **64**, 235408 (2001).
21. X. Z. Liao, J. Zou, D. J. H. Cockayne et al., *Phys. Rev. Lett.* **82**, 5148 (1999).
22. N. Liu, J. Tersoff, O. Baklenov et al., *Phys. Rev. Lett.* **84**, 234 (2000).
23. T. T. Basiev, I. T. Basieva, M. E. Doroshenko et al., *J. Luminescence* **94-95**, 349 (2001).